

ENT APPLICATION HS

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In the Patent Application of) 9331
Koichiro KISHIMA et al.)))
Application No.: To Be Assigned) Group Art Unit: To Be Assigned
Filed: August 21, 2001) Examiner: To Be Assigned
For: OPTICAL ELEMENT, METHOD FOR PRODUCING THE SAME, AND OPTICAL PICKUP)))

CLAIM TO PRIORITY UNDER 35 U.S.C. §119

Commissioner for Patents Washington, D.C. 20231

Sir:

The benefit of the filing date of the following prior application filed in the following foreign country is hereby requested and the right of priority provided under 35 U.S.C. §119 is hereby claimed:

Japanese Patent Appl. No. 2000-251240, filed August 22, 2000

In support of this claim, filed herewith is a certified copy of said original foreign application.

/ \

Respectfully submitted,

Dated: August 21, 2001

RADER, FISHMAN & GRAUER P.L.L.C.

1233 20TH Street, NW Suite 501 Washington, DC 20036

202-955-3750-Phone

202-955-3751-Fax

Customer No. 23353

Ronald V. Kananen

Reg. Nø. 24,104



日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年 8月22日

出 願 番 号

Application Number:

特願2000-251240

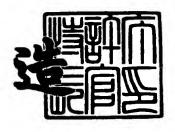
出 顏 人
Applicant(s):

ソニー株式会社

2001年 5月25日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office







【書類名】

特許願

【整理番号】

0000596703

【提出日】

平成12年 8月22日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G02B 3/00

G11B 7/00

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社

内

【氏名】

木島 公一朗

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社

内

【氏名】

河内山 彰

【特許出願人】

【識別番号】

000002185

【氏名又は名称】

ソニー株式会社

【代表者】

出井 伸之

【代理人】

【識別番号】

100094053

【弁理士】

【氏名又は名称】

佐藤 隆久

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

014890

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

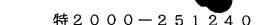
【物件名】

要約書



【包括委任状番号】 9707389

【プルーフの要否】 要





【書類名】 明細書

【発明の名称】 光学素子、光学素子の製造方法および光ピックアップ【特許請求の範囲】

【請求項1】

光学材料からなる基板を有する光学素子であって、

前記基板は、

凸レンズの機能を持つ凸部と、

前記凸部の周囲に位置する平坦部と、

前記平坦部の周囲に位置する外周部と

を有し、

前記外周部での前記基板の厚さは、前記平坦部での前記基板の厚さよりも厚い 光学素子。

【請求項2】

前記外周部での前記基板の厚さは、前記凸部での前記基板の厚さよりも厚い 請求項1記載の光学素子。

【請求項3】

前記外周部の表面は、平坦または略平坦である

請求項1記載の光学素子。

【請求項4】

前記外周部は、複数の段が形成されており、外側の段での前記基板の厚さは、 内側の段での前記基板の厚さよりも厚い

請求項1記載の光学素子。

【請求項5】

光学材料からなる基板上に、第1のマスク層と当該第1のマスク層を囲む第2 のマスク層とを形成する工程と、

前記第1のマスク層を熱処理により凸レンズの形状にする工程と、

前記第1のマスク層の前記凸レンズの形状が前記基板に転写されるように、前記基板をエッチングする工程と

を有する



光学素子の製造方法。

【請求項6】

前記第1および第2のマスク層を形成する工程では、前記基板上の感光性材料 からなるマスク層をパターニングすることにより、前記第1および第2のマスク 層を形成する

請求項5記載の光学素子の製造方法。

【請求項7】

前記第1のマスク層を熱処理により凸レンズの形状にする工程において、前記 熱処理温度は、前記第1のマスク層のガラス転移温度よりも高い

請求項5記載の光学素子の製造方法。

【請求項8】

前記第1のマスク層を熱処理により凸レンズの形状にする工程において、前記 熱処理温度は、前記第1のマスク層の炭化温度よりも低い

請求項5記載の光学素子の製造方法。

【請求項9】

前記第1のマスク層を熱処理により凸レンズの形状にする工程において、前記 熱処理温度は、室温または常温よりも高い

請求項5記載の光学素子の製造方法。

【請求項10】

前記第1および第2のマスク層を形成する工程では、開口部を有する前記第2 のマスク層を形成した後に、前記開口部に前記第1のマスク層を形成し、

前記第2のマスク層は、耐エッチング性の材料からなる

請求項5記載の光学素子の製造方法。

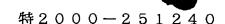
【請求項11】

前記第2のマスク層は、

耐エッチング性の材料からなる第3のマスク層と、

前記基板上の前記第3のマスク層を覆うように前記第3のマスク層上に積層された第4のマスク層と

を有し、





前記第4のマスク層は、前記第1のマスク層と同じ材料からなる 請求項5記載の光学素子の製造方法。

【請求項12】

レーザと、

前記レーザからのレーザ光を光ディスクに集光する光学素子と、 前記光ディスクで反射した前記レーザ光を受光する光検出器と を有する光ピックアップであって、

前記光学素子は、光学材料からなる基板を有し、

前記基板は、

前記レーザからのレーザ光を前記光ディスクに集光する凸部と、

前記凸部の周囲に位置する平坦部と、

前記平坦部の周囲に位置する外周部と

を有し、

前記外周部での前記基板の厚さは、前記平坦部での前記基板の厚さよりも厚い 光ピックアップ。

【請求項13】

前記外周部での前記基板の厚さは、前記凸部での前記基板の厚さよりも厚い 請求項12記載の光ピックアップ。

【請求項14】

前記外周部の表面は、平坦または略平坦である

請求項12記載の光ピックアップ。

【請求項15】

前記外周部は、複数の段が形成されており、外側の段での前記基板の厚さは内側の段での前記基板の厚さよりも厚い

請求項12記載の光ピックアップ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、光学素子と、光学素子の製造方法と、光学素子を有する光ピックア



ップとに関する。

[0002]

【従来の技術】

近年、光記録媒体の高密度化の要求がある。このため、光ディスク装置に関して、光源の短波長化および再生光学系の高NA(Numerical Aperture)化の研究開発が行われている。また、データの高転送レート化が望まれている。

[0003]

光源の短波長化および再生光学系の高NA化に関しては、光学スポットのサイズが小さくなることに加えて、焦点深度も浅くなることから、フォーカスサーボのとれ残り量を少なくすることが望まれると共に、光記録媒体におけるデータが記録されている幅(トラック幅)も狭くなるので、トラッキングサーボのとれ残り量を少なくすることが望まれる。

[0004]

また、データの高転送レート化に関しては、フォーカスサーボおよびトラッキングサーボを行うアクチュエータの高帯域化が望まれることとなり、結果的にサーボ特性には、とれ残り量を少なくすることと帯域の向上という2つの特性向上が望まれる。アクチュエータは、アクチュエータの軽量化によりサーボ特性を向上可能である。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

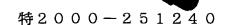
図1は、本発明に対比される光学素子を例示する説明図である。

この光学素子10は、光学材料からなる基板14Aを有する。基板14Aは、 凸レンズを構成する凸部11と、凸部11の周囲に位置する平坦部12とを有する。

[0006]

光学素子10は、板状の光学材料の表面に形成された円形のマスク層を熱処理 して表面張力によりレンズ形状にし、当該レンズ形状が光学材料に転写されるように板状の光学材料をエッチングすることで、形成可能である。

凸部11の外周には、エッチングによる転写時に形成されたトレンチという溝





19が形成されている。溝19により、凸部11と平坦部12との区別が明確化されている。

[0007]

図1の光学素子10では、凸部11以外の部分は、エッチングにより削られて 薄板状になっている。

この光学素子10を他の光学素子と組み合わせて使用する場合は、組み合わせる他の光学素子の光路を遮らないようにする必要がある。

[0008]

図2は、図1の光学素子10をレンズホルダにマウントした状態を示す説明図である。

図2(a)は、光学素子10の平坦部12の周縁をレンズホルダ10Aでクランプした場合を示している。

図2(b)は、光学素子10の平坦部12の上面をレンズホルダ10Bでクランプした場合を示している。

[0009]

図2に示すように、図1の光学素子10をレンズホルダ10A, 10Bに装着するには、平坦部12を広くする必要がある。

また、接着時の位置ずれおよび接着剤のはみ出しなどを考慮すると、他の光学素子と組み合わせて使用する場合に限らず、平坦部12を広くする必要がある。

[0010]

例えば、凸部 1 1 の凸レンズの有効径(直径)として約 2 0 0 μ m程度、凸部 1 1 の凸レンズの曲率半径として約 1 5 0 μ mである場合、平坦部 1 2 の厚さ(肉厚)は 5 0 μ m程度またはそれ以下となる。そして、接着工程における位置合わせ精度の許容値および接着剤のはみ出し量をあわせて約 5 0 0 μ mとすると、凸レンズは、厚さが約 5 0 μ mで長さが約 5 0 0 μ mの薄板上に位置することとなる。

このため、図1に示すような光学素子についての機械的強度の向上が望まれる。更には、平坦部12は薄いので、厚さ方向の振動による共振が発生し易くなるため、共振し難い構造とすることが望まれる。



[0011]

本発明の目的は、光学材料からなる基板を有する光学素子であって、機械的強度を向上可能な光学素子と、当該光学素子の製造方法と、当該光学素子を有する 光ピックアップとを提供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】

本発明に係る光学素子は、光学材料からなる基板を有する光学素子であって、 前記基板は、凸レンズの機能を持つ凸部と、前記凸部の周囲に位置する平坦部と 、前記平坦部の周囲に位置する外周部とを有し、前記外周部での前記基板の厚さ は、前記平坦部での前記基板の厚さよりも厚い。

[0013]

本発明に係る光学素子では、好適には、前記外周部での前記基板の厚さは、前記の部での前記基板の厚さよりも厚い。

本発明に係る光学素子では、好適には、前記外周部の表面は、平坦または略平坦である。

[0014]

本発明に係る光学素子では、好適には、前記外周部は、複数の段が形成されており、外側の段での前記基板の厚さは、内側の段での前記基板の厚さよりも厚い

[0015]

本発明に係る光学素子の製造方法は、光学材料からなる基板上に、第1のマスク層と当該第1のマスク層を囲む第2のマスク層とを形成する工程と、前記第1のマスク層を熱処理により凸レンズの形状にする工程と、前記第1のマスク層の前記凸レンズの形状が前記基板に転写されるように、前記基板をエッチングする工程とを有する。

[0016]

本発明に係る光学素子の製造方法では、好適には、前記第1および第2のマスク層を形成する工程では、前記基板上の感光性材料からなるマスク層をパターニングすることにより、前記第1および第2のマスク層を形成する。



[0017]

本発明に係る光学素子の製造方法では、好適には、前記第1のマスク層を熱処理により凸レンズの形状にする工程において、前記熱処理温度は、前記第1のマスク層のガラス転移温度よりも高い。

[0018]

本発明に係る光学素子の製造方法では、好適には、前記第1のマスク層を熱処理により凸レンズの形状にする工程において、前記熱処理温度は、前記第1のマスク層の炭化温度よりも低い。

[0019]

本発明に係る光学素子の製造方法では、好適には、前記第1のマスク層を熱処理により凸レンズの形状にする工程において、前記熱処理温度は、室温または常温よりも高い。

[0020]

本発明に係る光学素子の製造方法では、好適には、前記第1および第2のマスク層を形成する工程では、開口部を有する前記第2のマスク層を形成した後に、前記開口部に前記第1のマスク層を形成し、前記第2のマスク層は、耐エッチング性の材料からなる。

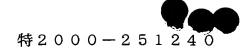
[0021]

本発明に係る光学素子の製造方法では、好適には、前記第2のマスク層は、耐エッチング性の材料からなる第3のマスク層と、前記基板上の前記第3のマスク層を覆うように前記第3のマスク層上に積層された第4のマスク層とを有し、前記第4のマスク層は、前記第1のマスク層と同じ材料からなる。

[0022]

本発明に係る光ピックアップは、レーザと、前記レーザからのレーザ光を光ディスクに集光する光学素子と、前記光ディスクで反射した前記レーザ光を受光する光検出器とを有する光ピックアップであって、前記光学素子は、光学材料からなる基板を有し、前記基板は、前記レーザからのレーザ光を前記光ディスクに集光する凸部と、前記凸部の周囲に位置する平坦部と、前記平坦部の周囲に位置する外周部とを有し、前記外周部での前記基板の厚さは、前記平坦部での前記基板





の厚さよりも厚い。

[0023]

本発明に係る光ピックアップでは、好適には、前記外周部での前記基板の厚さは、前記凸部での前記基板の厚さよりも厚い。

本発明に係る光ピックアップでは、好適には、前記外周部の表面は、平坦または略平坦である。

[0024]

本発明に係る光ピックアップでは、好適には、前記外周部は、複数の段が形成されており、外側の段での前記基板の厚さは内側の段での前記基板の厚さよりも厚い。

[0025]

光学材料からなる基板は、凸レンズの機能を持つ凸部と、凸部の周囲に位置する平坦部と、平坦部の周囲に位置する外周部とを有する。この外周部での基板の厚さは、平坦部での基板の厚さよりも厚いので、厚さが等しい場合に比べ、基板の機械的強度を向上することができ、光学素子の機械的強度および信頼性を向上可能である。

[0026]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を、添付図面を参照して説明する。

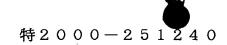
[0027]

図3は、本発明に係る光学素子の実施の形態を示す説明図である。

この光学素子20は、光学材料からなる基板24Aを有する。基板24Aは、 凸レンズの機能を有する凸部21と、凸部21の周囲に位置する平坦部22と、 平坦部22の周囲に位置する外周部23とを有する。外周部23での基板24A の厚さ(肉厚)は、平坦部22での基板24Aの厚さ(肉厚)よりも厚く、外周 部23の表面(上面)は平坦である。

[0028]

この光学素子20では、凸部21は小型・軽量であって高精度であると共に、 外周部23が平坦部22よりも厚いので、薄肉の平坦部22が少なくなっており



、機械的強度が向上している。更には、薄肉の平坦部22が少ないので、曲げ強度も向上しており、厚さ方向の振動の共振周波数が高められ、共振し難い構造になっている。

[0029]

また、光学素子20は、外周部23が厚く形成されているので、機械的強度を 維持しつつ、光学素子20のサイズを大きくすることができる。

これにより、接着剤のはみ出し量の許容値を大きくすることができることから レンズホルダへのマウント工程が容易になると共に、レンズホルダの取り付け部 分の径も大きくすることができ、更にその精度も緩和することができるので、光 学素子20をマウントするレンズホルダの精度を緩和可能である。

[0030]

光学素子の製造方法の第1実施形態

次に、光学素子の製造方法を説明する。

図4は、図3の光学素子20の製造工程を示す説明図である。

図4 (a)では、光学材料からなる基板24上にマスク層25が塗布されている。マスク層25は、例えば感光性材料(またはホトレジスト)からなり、スピンコーティング法などにより所定の厚さに塗布されている。マスク層25の厚さは、一例として約25μmとする。

[0031]

図4 (b)では、図4 (a)の基板24上のマスク層25のパターニングにより、第1のマスク層26と、第2のマスク層27とが形成されている。マスク層25のパターニングは、例えば露光および現像により行う。第1のマスク層26と第2のマスク層27との間隔は、一例として約50 μ mとし、第1のマスク層26の直径は、一例として約100 μ m~約250 μ mとする。

[0032]

図4 (c)では、図4 (b)の基板24 (または基板24上のマスク層26,27)に熱処理を行い、マスク層26,27の表面積が表面張力等により少なくなるような変形をさせ、なだらかな曲面を有する凸形状に変形させる。

熱処理により、図4 (b) のマスク層26, 27は、図4 (c) のマスク層2

6A, 27Aになっており、マスク層26Aは丸い凸形状(凸レンズ形状)を有する。

[0033]

図4 (d)では、図4 (c)のマスク層26A,27Aの形状が基板24に転写されて基板24Aが形成されており、光学素子20が形成されている。例えば、リアクティブイオンエッチング(RIE)法などのエッチングにより、マスク層26A,27Aの形状を基板24に転写し、光学素子20を形成する。

凸部21は、マスク層26Aが転写されて形成されており、平坦部22は、マスク層26A,27A間の形状が転写されて形成されており、外周部23は、マスク層27Aの形状が転写されて形成されており、表面が平坦または略平坦になっている。凸部21の外周には溝29が形成されており、平坦部22の外周には溝28が形成されている。溝28,29により、凸部21、平坦部22および外周部23の区別が明確化されている。

[0034]

凸部21を形成するエッチングでは、例えば、NLD (Magnetic Neutral Loop Discharge Plasma) 装置という高密度プラズマ源を用いたプラズマエッチング 装置により加工を行う。なお、NLD装置に関しては、H.Tsuboi,M.Itoh,M.Tana be,T.Hayashi and T.Uchida:Jpn.J.Appl.Phys.34(1995),2476 を参考にすること ができる。

または、ICP (Inductively Coupled Plasma) 装置という高密度プラズマ源を用いたプラズマエッチング装置により加工を行う。なお、ICP装置に関しては、J.Hopwood,Plasma Source,Sci.& Technol.1(1992)109. を参考にすることができ、T.Fukasawa,A.Nakamura,H.Shindo and Y.Horiike:Jpn.J.Appl.Phys.33(1994),2139を参考にすることができる。

[0035]

図4に示す製造方法によれば、凸レンズの機能を有する凸部21を形成すると 共に肉厚の外周部23を形成することができる。また、凸部21と外周部23と の位置精度は、マスク層25のパターニングの精度を維持することができるので 、高い位置精度で凸部21と外周部23とを作製することができる。これにより

、凸部21の周囲に位置する薄肉の平坦部22を少なくすることができ、例えば 感光性材料の解像度まで狭くすることが可能である。

また、光学素子20は、平坦部22の周囲に厚肉の外周部23が形成されており、図4の製造方法を用いることで、ガラスモールド法では作成が困難な形状の光学素子を作成可能である。

[0036]

図4の製造方法では、一例として、マスク層25は、ガラス転移温度(Tg点)が約45 \mathbb{C} ~約55 \mathbb{C} の材料を用い、熱処理温度は、約110 \mathbb{C} ~約150 \mathbb{C} の範囲で行う。

また、第1のマスク層26が熱処理により、光学的になだらかな面が得られる程度に丸く変形させるため、マスク層25の材料をTg点が熱処理温度よりも低い材料としている。

[0037]

更には、ドライエッチングなどの製法により第1のマスク層26の形状を基板24に形成する場合には、熱処理後のマスク層26A,27Aが変質していないことが必要であることから、熱処理温度は、マスク層26A,27Aが変質しない温度としている。例えば、熱処理温度は、第1のマスク層26の炭化温度よりも低い温度とする。

[0038]

マスク層 2 6, 2 7 が形成された基板 2 4 の保持状態において、マスク層 2 6, 2 7 が変形すると、プロセスの再現(再現性)が困難となる。また、ドライエッチングプロセス中においてマスク層 2 6, 2 7 が変形するとプロセスの再現が困難となる。

このため、マスク層 2 5 の材料は、T g 点が保存温度(室温もしくは常温)または加工プロセス温度(室温付近もしくは常温付近)よりも高い材料としている

[0039]

一般的に、Tg点とは、その材料がガラス状態(すなわち決まった構造をとらず、流動が可能な状態)となる境界を示す温度であることから、プロセスの安定

性を考えると、熱処理温度は、Tg点よりも余裕を持って高い温度であることが 望ましい。

すなわち、マスク層26を熱処理によりその表面積が小さくなるように変形させる(熱処理によりマスク層26の流動が可能な状態とし、マスク層26の表面 張力によりマスク層26を変形させる)ためには、熱処理温度はTg点よりも数 10℃高いことが望ましい。

[0040]

一例として、熱処理温度をTg点よりも40℃程度以上高い温度とすることにより、例えば1時間以内にマスク層26を丸く変形させることができ、効率良く 光学素子20を製造可能である。

なお、同様の観点から保存温度または加工温度とTg点との関係においては、 保存温度または加工温度とTg点との差は、数10℃以内としてもよい。

[0041]

光学素子の製造方法の第2実施形態

次に、本発明の光学素子の製造方法の第2の実施の形態を、図5および図6を 参照して説明する。

図5 (a)では、光学材料からなる基板34上に、開口部37Hを有する第2のマスク層37Bが形成されている。この第2のマスク層37Bは、耐エッチング性の材料からなり、その厚さは一例として約0.1μmとする。第2のマスク層37Bは、例えば、プラチナなどの無機材料により構成してもよく、ハードマスクにより構成してもよい。

[0042]

図5(b)では、図5(a)の基板34上にマスク層35が塗布されている。 マスク層35は、例えば感光性材料(またはホトレジスト)からなり、スピンコーティング法などにより所定の厚さに塗布されている。マスク層35の厚さは、

一例として約25μmとする

[0043]

図5(c)では、図5(b)の基板34上のマスク層35のパターニングにより、第1のマスク層36が形成されていると共に、第2のマスク層37Bが露出

している。マスク層35のパターニングは、例えば露光および現像により行う。 第1のマスク層36の直径は、一例として約100μm~約250μmとする。

[0044]

図6(d)では、図5(c)の基板34(または基板34上の第1のマスク層36)に熱処理を行い、第1のマスク層36の表面積が表面張力で少なくなるような変形をさせ、なだらかな曲面を有する凸形状に変形させる。

熱処理により、図5 (c)のマスク層36は、図6 (d)のマスク層36Aになっており、マスク層36Aは丸い凸形状(凸レンズ形状)を有する。

[0045]

図6(e)では、図6(d)のマスク層36Aの形状が基板34に転写されて基板34Aが形成されており、光学素子30が形成されている。

例えば、RIE法などのエッチングにより、マスク層36Aの形状を基板34に転写し、光学素子30を形成する。マスク層37Bは、凸部31形成用のエッチング時にエッチングされない材料もしくはエッチングされ難い材料またはエッチングレートが小さい材料で構成されている。また、凸部31形成用のエッチングでは、例えば、NLD装置またはICP装置を用いる。

[0046]

凸部31は、マスク層36Aが転写されて形成されており、平坦部32は、マスク層36A,37B間の形状が転写されて形成されており、外周部33は、マスク層37Bによりマスクされており、エッチングされていない。外周部33の表面は、平坦または略平坦である。

凸部31の外周には、溝39が形成されている。この溝39により、凸部31 と平坦部32との区別が明確化されている。

[0047]

図5および図6に示す製造方法によれば、凸レンズの機能を有する凸部31を 形成すると共に肉厚の外周部33を形成することができる。また、凸部31と外 周部33との位置精度は、マスク層35のパターニングの精度を維持することが できるので、高い位置精度で凸部31と外周部33とを作成することができる。 これにより、凸部31の周囲に位置する薄肉の平坦部32を少なくすることがで き、例えば感光性材料の解像度まで狭くすることが可能である。

[0048]

更には、外周部33での肉厚を、凸部31での肉厚よりも大きくすることができるので、光学素子30は、機械的強度をより向上可能であると共に、厚さ方向の振動の共振周波数を高めることができ、共振し難くすることができる。

また、光学素子30では、平坦部32の周囲に厚肉の外周部33が形成されており、図5および図6の製造方法を用いることで、ガラスモールド法では作成が 困難な形状の光学素子を作成可能である。

[0049]

なお、図5(a)の第2のマスク層37Bは、リフトオフ法などにより形成することができ、この形成工程ではレジストのリムーバなどの使用を伴うので、マスク層35が感光性材料などの有機材料である場合には、第2のマスク層37Bの形成工程をマスク層35,36の形成工程よりも前にすることが望ましい。

また、第2のマスク層37Bは、図6(e)の基板34Aの加工工程で加工されないことが望ましいので、図6(e)の工程としては、イオンミリング法よりも、化学的な反応を利用しているRIE法のほうが好ましい。

[0050]

図 5 および図 6 の製造方法では、一例として、マスク層 3 5 は、ガラス転移温度(T g 点)が約 4 5 $\mathbb C$ \sim 約 5 5 $\mathbb C$ の材料を用い、熱処理温度は、約 1 1 0 $\mathbb C$ \sim 約 1 5 0 $\mathbb C$ の範囲で行う。

また、第1のマスク層36が熱処理により、光学的になだらかな面が得られる程度に丸く変形させるため、マスク層35の材料はTg点が熱処理温度よりも低い材料としている。

[0051]

更には、ドライエッチングなどの製法により第1のマスク層36の形状を基板34に形成する場合には、熱処理後のマスク層36Aが変質していないことが必要であることから、熱処理温度は、マスク層36Aが変質しない温度としている。例えば、熱処理温度は、第1のマスク層36の炭化温度よりも低い温度とする

[0052]

マスク層36,37Bが形成された基板34の保持状態において、マスク層36が変形すると、プロセスの再現(再現性)が困難となる。また、ドライエッチングプロセス中においてマスク層36,37Aが変形するとプロセスの再現が困難となる。

このため、マスク層35の材料は、Tg点が保存温度(室温もしくは常温)または加工プロセス温度(室温付近もしくは常温付近)よりも高い材料としている

[0053]

プロセスの安定性の観点から、熱処理温度は、Tg点よりも余裕を持って高い 温度であることが望ましい。

すなわち、マスク層36を熱処理によりその表面積が小さくなるように変形させる(熱処理によりマスク層36の流動が可能な状態とし、マスク層36の表面 張力によりマスク層36を変形させる)ためには、熱処理温度はTg点よりも数 10℃高いことが望ましい。

[0054]

一例として、熱処理温度をTg点よりも40℃程度以上高い温度とすることにより、例えば1時間以内にマスク層36を丸く変形させることができ、効率良く 光学素子30を製造可能である。

なお、同様の観点から保存温度または加工温度とTg点との関係においては、 保存温度または加工温度とTg点との差は、数10℃以内としてもよい。

[0055]

光学素子の製造方法の第3実施形態

次に、本発明の光学素子の製造方法の第3の実施の形態を、図7および図8を 参照して説明する。

図7(a)では、光学材料からなる基板44上に、開口部47Hを有する第3のマスク層47Bが形成されている。この第3のマスク層47Bは、耐エッチング性の材料からなり、その厚さは一例として約0.1μmとする。第3のマスク層47Bは、例えば、プラチナなどの無機材料により構成してもよく、ハードマ

スクにより構成してもよい。

[0056]

図7(b)では、図7(a)の基板44上にマスク層45が塗布されている。マスク層45は、例えば感光性材料(またはホトレジスト)からなり、スピンコーティング法などにより所定の厚さに塗布されている。マスク層45の厚さは、一例として約25μmとする。なお、マスク層45は、上記マスク層35と同一の材料とする。

[0057]

図7(c)では、図7(b)の基板44上のマスク層45のパターニングにより、第1のマスク層46および第2のマスク層47Cが形成されている。

第2のマスク層47Cは、第3のマスク層47Bと、この第3のマスク層47 Bを覆うように積層された第4のマスク層47とを有する。

第4のマスク層47は、第3のマスク層47Bよりもマスク層46に近い配置となっている。マスク層45のパターニングは、例えば露光および現像により行う。第1のマスク層46と第2のマスク層47Cとの間隔は、一例として約50μmとし、第1のマスク層46の直径は、一例として約100μm~約250μmとする。

[0058]

図8(d)では、図7(c)の基板44(または基板44上の第1および第2のマスク層46,47C)に熱処理を行い、マスク層46の表面積が表面張力で少なくなるような変形をさせ、なだらかな曲面を有する凸形状に変形させる。

熱処理により、図7(c)のマスク層46,47は、図8(d)のマスク層46A,47Aになっており、マスク層46Aは丸い凸形状(凸レンズ形状)を有する。

[0059]

図8(e)では、図8(d)のマスク層46A,47Aの形状が基板44に転写されて基板44Aが形成されており、光学素子40が形成されている。例えば、RIE法などのエッチングにより、マスク層46A,47Aの形状を基板44に転写し、光学素子40を形成する。マスク層47Bは、凸部41形成用のエッ

チング時にエッチングされない材料もしくはエッチングされ難い材料またはエッチングレートが小さい材料で構成されている。また、凸部41形成用のエッチングでは、例えば、NLD装置またはICP装置を用いる。

[0060]

凸部41は、マスク層46Aが転写されて形成されており、平坦部42は、マスク層46A,47A間の形状が転写されて形成されている。

外周部43は、内側の第1の外周部43Aと、外側の第2の外周部43Bとを有し、第1の外周部43Aの肉厚は第2の外周部43Bの肉厚よりも小さく、段(2段)を形成している。また、第2の外周部43Bは、マスク層47Bによりマスクされており、エッチングされていない。第1および第2の外周部43A、43Bの表面は、平坦または略平坦である。凸部41の外周には溝49が形成されており、平坦部42の外周には溝48が形成されている。溝48,49により、凸部41、平坦部42および外周部43の区別が明確化されている。

[0061]

図7および図8に示す製造方法によれば、凸レンズの機能を有する凸部41を 形成すると共に肉厚の外周部43を形成することができる。また、凸部41と外 周部43との位置精度は、マスク層45のパターニングの精度を維持することが できるので、高い位置精度で凸部41と外周部43とを作成することができる。 これにより、凸部41の周囲に位置する薄肉の平坦部42を少なくすることがで き、例えば感光性材料の解像度まで狭くすることが可能である。

更には、外周部43(第2の外周部43B)を、凸部41よりも肉厚にすることができるので、光学素子40の機械的強度をより向上可能であると共に、厚さ方向の振動の共振周波数を高めることができ、共振し難い構造にすることができる。

[0062]

図8(e)の光学素子40は、凸部41に近い第1の外周部43Aが第2の外 周部43Bよりも薄肉になっているので、光路を遮り難い構造となっており、い わゆるけられを防止可能な構造となっている。

また、このような構造により、図 6 (e) の光学素子 3 O と比べ、外周部を凸

部の近くまで形成でき、機械的強度および共振周波数をいっそう向上可能である

また、光学素子40では、平坦部42の周囲に厚肉部43が形成されており、 図7および図8の製造方法を用いることで、ガラスモールド法では作成が困難な 形状の光学素子を作成可能である。

[0063]

光ピックアップ

図9は、本発明に係る光学素子を有する光ピックアップの第1の実施の形態を 示す構成図である。

この光ピックアップ1は、半導体レーザ4と、コリメータレンズ5と、ビームスプリッタ3と、1/4波長板(λ /4板)9と、集光レンズ6と、光検出器8と、光学素子20とを有する。この光学素子20は、アームに取り付けられたスライダとしてもよく、2軸アクチュエータによりフォーカス方向およびトラッキング方向に移動する構成としてもよい。

[0064]

半導体レーザ4は、駆動信号SLに基づいて直線偏光のレーザ光を出力し、出力レーザ光をコリメータレンズ5に供給する。

コリメータレンズ5は、半導体レーザ4からのレーザ光を平行光にしてビーム スプリッタ3に供給する。

ビームスプリッタ3は、コリメータレンズ5からのレーザ光を透過して1/4 波長板9を介して光学素子20の凸部21に供給する。

光学素子20の凸部21は、対物レンズの機能を有し、ビームスプリッタ3からのレーザ光を集光して光ディスク80のトラックに供給する。このようにして、半導体レーザ4からのレーザ光は、光ディスク80の記録面に集光される。

[0065]

また、光学素子20は、光ディスク80で反射したレーザ光を、1/4波長板9を介してビームスプリッタ3に戻す。

ビームスプリッタ3は、光学素子20からのレーザ光が入射され、入射された レーザ光を反射して集光レンズ6に供給する。 集光レンズ6は、ビームスプリッタ3からのレーザ光を集光して光検出器8に 供給する。

光検出器 8 は、集光レンズ 6 からのレーザ光を受光部で受光して出力信号 S A を生成する。光検出器 8 は、例えば 4 分割光検出器により構成する。

[0066]

図9の光ピックアップ1では、光学素子20を用いることにより、図1の光学素子10を用いた光ピックアップに比べて共振周波数を向上することができ、これにより高転送レートのデータの記録および/または再生が可能となる。また、光学素子20を用いることにより、光ピックアップの機械的強度および信頼性を向上可能である。

[0067]

図10は、本発明に係る光学素子を有する光ピックアップの第2の実施の形態 を示す構成図である。

この光ピックアップ1Aは、半導体レーザ4と、コリメータレンズ5と、ビームスプリッタ3と、1/4波長板(2/4板)9と、集光レンズ6と、光検出器8と、光学素子30とを有する。この光学素子30は、アームに取り付けられたスライダとしてもよく、2軸アクチュエータによりフォーカス方向およびトラッキング方向に移動する構成としてもよい。

[0068]

半導体レーザ4は、駆動信号SLに基づいて直線偏光のレーザ光を出力し、出力レーザ光をコリメータレンズ5に供給する。

コリメータレンズ5は、半導体レーザ4からのレーザ光を平行光にしてビーム スプリッタ3に供給する。

ビームスプリッタ3は、コリメータレンズ5からのレーザ光を透過して1/4 波長板9を介して光学素子30の凸部31に供給する。

光学素子30の凸部31は、対物レンズの機能を有し、ビームスプリッタ3からのレーザ光を集光して光ディスク80のトラックに供給する。このようにして、半導体レーザ4からのレーザ光は、光ディスク80の記録面に集光される。

[0069]

また、光学素子30は、光ディスク80で反射したレーザ光を、1/4波長板9を介してビームスプリッタ3に戻す。

ビームスプリッタ3は、光学素子30からのレーザ光が入射され、入射された レーザ光を反射して集光レンズ6に供給する。

集光レンズ6は、ビームスプリッタ3からのレーザ光を集光して光検出器8に供給する。

光検出器 8 は、集光レンズ 6 からのレーザ光を受光部で受光して出力信号 S A を生成する。光検出器 8 は、例えば 4 分割光検出器により構成する。

[0070]

図10の光ピックアップ1Aでは、光学素子30を用いることにより、図1の 光学素子10を用いた光ピックアップに比べて共振周波数を向上することができ 、これにより高転送レートのデータの記録および/または再生が可能となる。ま た、光学素子30を用いることにより、光ピックアップの機械的強度および信頼 性を向上可能である。

[0071]

図11は、本発明に係る光学素子を有する光ピックアップの第3の実施の形態を示す構成図である。

この光ピックアップ1Bは、半導体レーザ4と、コリメータレンズ5と、ビームスプリッタ3と、1/4波長板(λ/4板)9と、集光レンズ6と、光検出器8と、光学素子40とを有する。この光学素子40は、アームに取り付けられたスライダとしてもよく、2軸アクチュエータによりフォーカス方向およびトラッキング方向に移動する構成としてもよい。

[0072]

半導体レーザ4は、駆動信号SLに基づいて直線偏光のレーザ光を出力し、出力レーザ光をコリメータレンズ5に供給する。

コリメータレンズ5は、半導体レーザ4からのレーザ光を平行光にしてビーム スプリッタ3に供給する。

ビームスプリッタ3は、コリメータレンズ5からのレーザ光を透過して1/4 波長板9を介して光学素子40の凸部41に供給する。 光学素子40の凸部41は、対物レンズの機能を有し、ビームスプリッタ3からのレーザ光を集光して光ディスク80のトラックに供給する。このようにして、半導体レーザ4からのレーザ光は、光ディスク80の記録面に集光される。

[0073]

また、光学素子40は、光ディスク80で反射したレーザ光を、1/4波長板9を介してビームスプリッタ3に戻す。

ビームスプリッタ3は、光学素子40からのレーザ光が入射され、入射された レーザ光を反射して集光レンズ6に供給する。

集光レンズ6は、ビームスプリッタ3からのレーザ光を集光して光検出器8に 供給する。

光検出器 8 は、集光レンズ 6 からのレーザ光を受光部で受光して出力信号 S A を生成する。光検出器 8 は、例えば 4 分割光検出器により構成する。

[0074]

図11の光ピックアップ1Bでは、光学素子40を用いることにより、図1の 光学素子10を用いた光ピックアップに比べて共振周波数を向上することができ 、これにより高転送レートのデータの記録および/または再生が可能となる。ま た、光学素子40を用いることにより、光ピックアップの機械的強度および信頼 性を向上可能である。

[0075]

なお、上記実施の形態は本発明の例示であり、本発明は上記実施の形態に限定 されない。

[0076]

【発明の効果】

以上に説明したように、本発明の光学素子は、外周部が厚く形成されているために、外周部よりも薄い平坦部を少なくすることができ、機械的強度を増すことができる。また、薄肉の平坦部の減少により曲げ強度も増しており、厚さ方向の 共振周波数は高められ、共振し難い構造にすることができる。

[0077]

更に、本発明の光学素子は、薄肉の平坦部の減少により、光学素子のサイズを

大きくすることができる。これにより、接着剤のはみ出し量の許容値を大きくすることが可能となることからレンズホルダへのマウント工程が容易になると共に、レンズホルダに形成される取り付け部分の径も大きくすることができ、その精度も緩和できるので、この光学素子をマウントするレンズホルダの精度を緩和可能である。

[0078]

本発明の光学素子の製造方法によれば、凸部を形成する場合に、工程を増すことなく又は殆んど増すことなく、肉厚の外周部を形成することができる。また、凸部と外周部との位置精度は、マスク層のパターニングの位置精度を維持することができるので、高精度に作製することができ、凸部の外周の平坦部を少なくすることができ、例えばマスク層の材料の解像度程度まで狭くすることが可能である。

[0079]

更に、本発明の光学素子の製造方法によれば、外周部のマスク層の材料として 耐エッチング性の材料を用いることにより、外周部を凸部よりも厚くすることが でき、機械的強度および共振周波数をより向上可能である。

[0080]

また、外周部のマスク層として積層構造のマスク層を用いることにより、厚肉の外周部が多段構造の光学素子を作成することができ、外周部が光路を遮り難い構造にすることができるので、厚肉の外周部を凸部の近くまで形成でき、機械的強度および共振周波数をいっそう向上可能である。

[0081]

また、本発明に係る光ピックアップによれば、上記本発明に係る光学素子を有する光ピックアップを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明に対比される光学素子を例示する説明図である。

【図2】

図1の光学素子をレンズホルダにマウントした状態を示す説明図である。

【図3】

本発明に係る光学素子の実施の形態を示す説明図である。

【図4】

図3の光学素子を製造する製造方法を示す説明図である。

【図5】

本発明の光学素子の製造方法の第2の実施の形態を示す概略的な説明図である

【図6】

図5に続いて、本発明の光学素子の製造方法の第2の実施の形態を示す概略的 な説明図である。

【図7】

本発明の光学素子の製造方法の第3の実施の形態を示す概略的な説明図である

【図8】

図7に続いて、本発明の光学素子の製造方法の第3の実施の形態を示す概略的 な説明図である。

【図9】

本発明に係る光学素子を有する光ピックアップの第1の実施の形態を示す構成 図である。

【図10】

本発明に係る光学素子を有する光ピックアップの第2の実施の形態を示す構成 図である。

【図11】

本発明に係る光学素子を有する光ピックアップの第3の実施の形態を示す構成 図である。

【符号の説明】

1, 1A, 1B…光ピックアップ、3…ビームスプリッタ、4…半導体レーザ、5…コリメータレンズ、6…集光レンズ、8…光検出器、9…1/4波長板、10, 20, 30, 40…光学素子、10A, 10B…レンズホルダ、11, 2

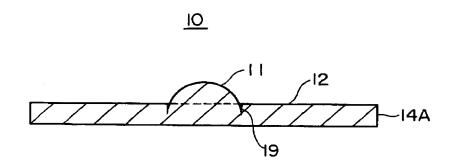
1,31,41…凸部、12,22,32,42…平坦部、13,23,33,43…外周部、19,28,29…溝、24,24A,34,34A,44,44A…基板、25,35…マスク層、26,36,46…第1のマスク層、27,37B,47C…第2のマスク層、37H,47H…開口部、43A…第1の外周部、43B…第2の外周部、47…第4のマスク層、47B…第3のマスク層、80…光ディスク。

2 4

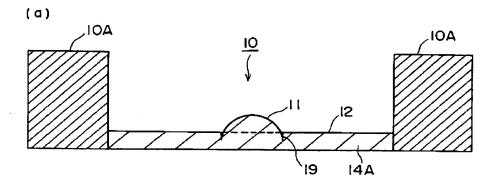
【書類名】

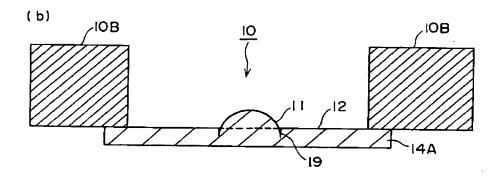
図面

【図1】

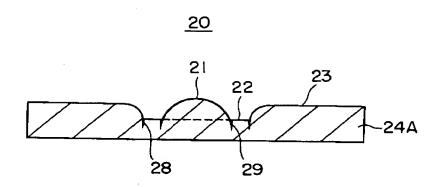


【図2】

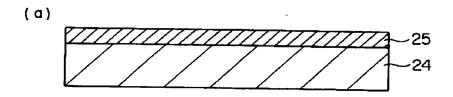


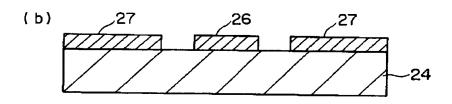


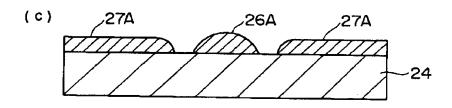
【図3】

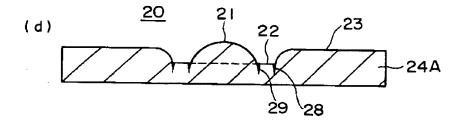


【図4】

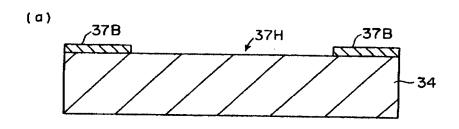


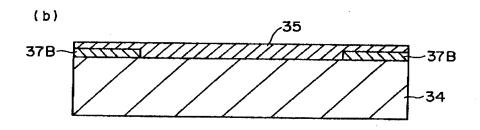


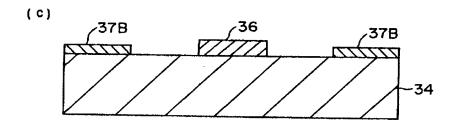




【図5】

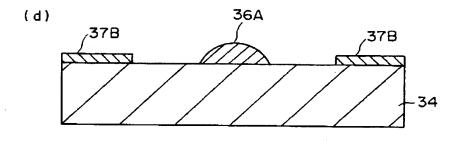


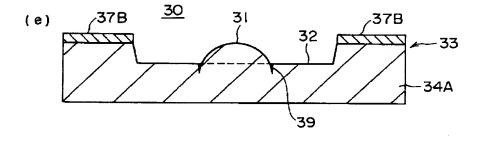




5

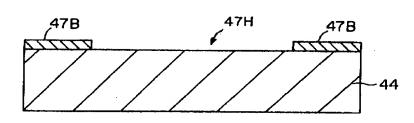
【図6】

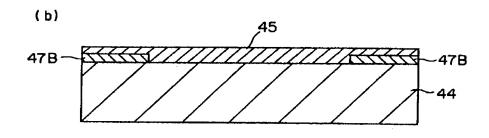


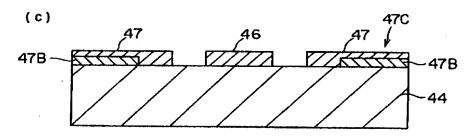


【図7】

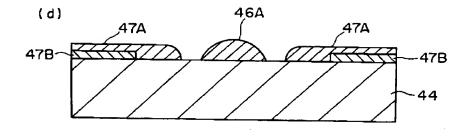


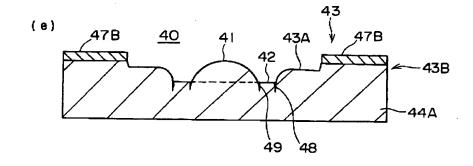




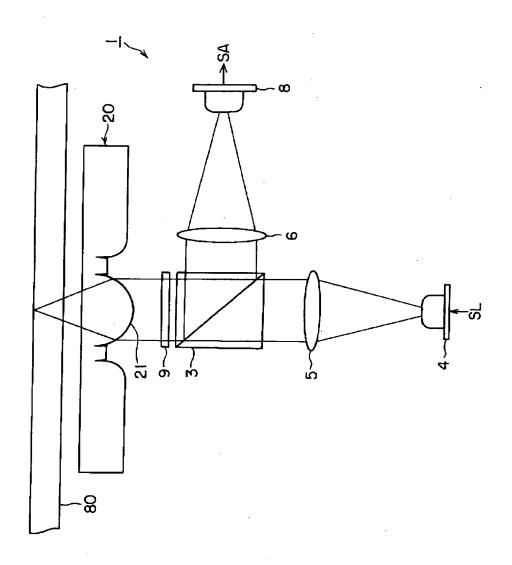


【図8】

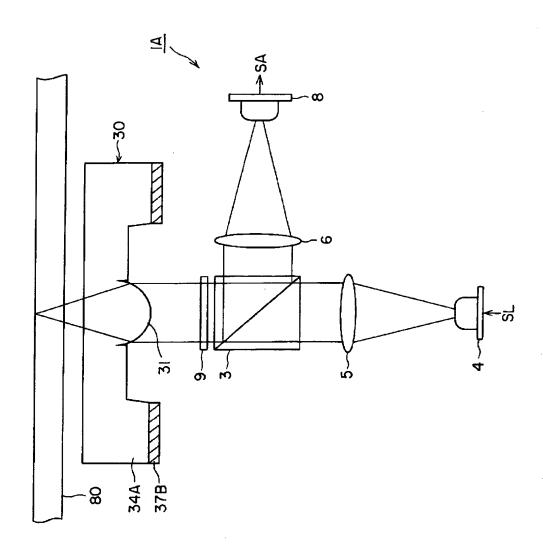




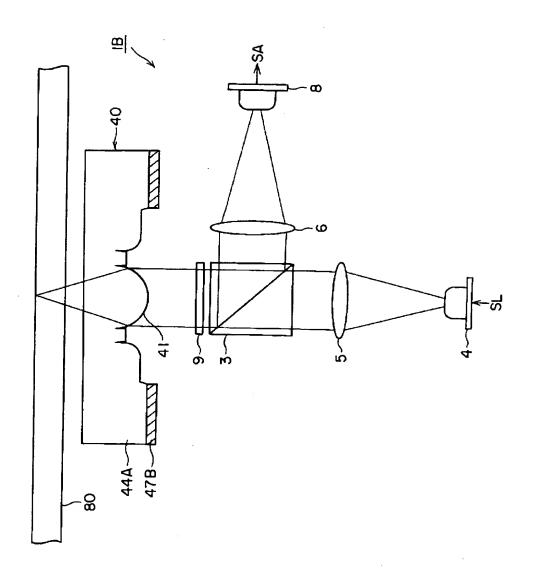
【図9】



【図10】



【図11】



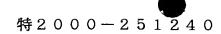
【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 光学材料からなる基板を有する光学素子であって、機械的強度を向上 可能な光学素子を提供する。

【解決手段】 光学素子20は、光学材料からなる基板24Aを有する。基板24Aは、凸レンズの機能を持つ凸部21と、凸部21の周囲に位置する平坦部22と、平坦部22の周囲に位置する外周部23とを有する。外周部23での基板24Aの厚さは、平坦部22での基板24Aの厚さよりも厚い。

【選択図】 図3



出願人履歴情報

識別番号

[000002185]

1. 変更年月日

1990年 8月30日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都品川区北品川6丁目7番35号

氏 名

ソニー株式会社